



「GaN p 型イオン注入」

- ◇ 日時: 2020年11月16日(月) 13:00~18:00
- ◇ 場所: オンライン(Zoomミーティング)開催

半導体電子デバイスを実用化するうえでイオン注入技術は不可欠である。GaNに関しては、n型層形成に関する報告例は多数あるが、p型層に関しては実現が困難であるのが、現状である。そこでGaNのイオン注入によるp型領域形成技術、p型GaN活性化率向上策について専門家を中心に議論する。注入温度や保護膜を用いた注入に関するプロセス、RTA、高温熱処理、レーザーアニール、など各種活性化熱処理方法の比較だけでなく、各種の分析的手法、欠陥挙動の知見等も盛り込み、今後の研究の方向を探る。

.....プログラム.....

13:00 会場

13:00~13:05 開会の挨拶、本日の進行説明

13:05~13:15 イントロダクトリー

須田 淳 (名古屋大学)

13:15~13:55 Mg イオン注入を用いた GaN の特性およびデバイス応用

田中 亮 (富士電機)

13:55~14:35 Mg-GaN 熱処理の歩み

加地 徹 (名古屋大学)

14:35~14:50 休憩

14:50~15:30 陽電子消滅による結晶欠陥評価

上殿 明良 (筑波大学)

15:30~15:50 高温注入による GaN 基板の TEM による結晶性評価

川野輪 仁 (株式会社イオンテクノセンター)

15:50~16:10 イオン注入 GaN の分析・解析

高橋 和照 (ユーロフィンイーエージー)

16:10~16:30 GaN への Mg チャネリング注入とそのシミュレーション手法

西村 智朗 (法政大学)

16:30~16:50 休憩

16:50~17:20 参加者からの情報提供も踏まえた討議

17:20~17:30 休憩

17:30~17:55 全体を通しての質疑および討議

17:55~18:00(18:30) 閉会の挨拶

■参加について: GaNのイオン注入によるp型領域形成技術や、p型GaN活性化率向上策について、全員参加で議論を行う討論会です。情報収集のみの参加はお断りします。WEBから参加申し込みを行っていただく際に、議論できる内容や取り組んでいる研究の概要、提供可能な話題などについて事前質問入力フォームに記述いただけます。参加申し込み多数の場合は、申し込み時のアンケートをもとに選定させていただきます。また、参加者によるディスカッションを活発にするため、当日プレゼン用スライドを1~3枚ご準備頂きます。

■参加受付: WEB参加受付システム(ここをクリック)から参加登録をお願いします。締切10月30日(金)。本案内が印刷物の場合、<https://annex.jsap.or.jp/limesurvey/index.php/676128/lang-ja>よりアクセス下さい。

■参加費 (消費税込) 参加申込み後、オンライン決済についてご案内致します。

先進パワー半導体分科会会員* 2,000円、一般 4,000円、分科会学生会員:無料(分科会入会予定を含む)

*11/9(月)に配布資料およびZoom-IDを配信致します。以降の返金は申し受けできません。

■問い合わせ先

岡 徹(豊田合成)	TEL: 052-449-5790	e-mail: toru.oka@toyoda-gosei.co.jp
堀切 文正(サイオクス)	TEL: 0294-42-5025	e-mail: horikirif@sc.sumitomo-chem.co.jp
菊田 大悟(豊田中央研究所)	TEL: 0561-71-7507	e-mail: kikuta-d@mosk.tytlabs.co.jp